

請求の範囲

- [請求項1] ポリエステル系樹脂から形成されている基材層と、
導電性フィラーを含む四フッ化エチレン系樹脂から形成されている
表面層と
を有し、且つ
表面抵抗率 R_s が $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下である、
離型フィルム。
- [請求項2] 前記導電性フィラーがカーボンブラックを含み、且つ、
前記四フッ化エチレン系樹脂が、レーザー回折式粒度分析測定法に
従い測定されたときの平均粒径が $1 \mu m \sim 15 \mu m$ である粒子を含む
、
請求項1に記載の離型フィルム。
- [請求項3] 前記カーボンブラックが、ケッチェンブラックを含む、請求項2に
記載の離型フィルム。
- [請求項4] 前記ケッチェンブラックのDBP吸油量が $250 ml / 100 g$ 以
上である、請求項3に記載の離型フィルム。
- [請求項5] 前記カーボンブラックが、ファーネスブラックをさらに含む、請求
項3又は4に記載の離型フィルム。
- [請求項6] 前記カーボンブラックが、ファーネスブラックを含む、請求項2に
記載の離型フィルム。
- [請求項7] 前記粒子が無機粒子である、請求項2～6のいずれか一項に記載の
離型フィルム。
- [請求項8] 前記無機粒子が二酸化ケイ素粒子である、請求項7に記載の離型フ
ィルム。
- [請求項9] 前記導電性フィラーが、カーボンブラックを含み、
当該カーボンブラックが、ケッチェンブラックとファーネスブラッ
クとを含む、
請求項1に記載の離型フィルム。

- [請求項10] 前記ポリエステル系樹脂が、ポリエチレンテレフタレート系樹脂である、請求項1～9のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項11] 前記ポリエステル系樹脂のガラス転移温度が60℃～95℃である、請求項1～10のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項12] 前記表面層が、前記基材層の2つの面のうちの一方の面に積層されている、請求項1～11のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項13] 前記基材層の2つの面のうちの他方の面に、フッ素系樹脂から形成されている表面層が積層されている、請求項12に記載の離型フィルム。
- [請求項14] 半導体装置の封止のために用いられる、請求項1～13のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項15] 前記封止において、前記導電性フィラーを含む四フッ化エチレン系樹脂から形成されている前記表面層が封止用樹脂に接するように配置される、請求項14に記載の離型フィルム。
- [請求項16] トランスファーモールド成形又はコンプレッションモールド成形のために用いられる、請求項1～15のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項17] 2回以上の成形のために用いられる、請求項1～16のいずれか一項に記載の離型フィルム。
- [請求項18] ポリエステル系樹脂から形成されている基材層の2つの面のうちの一方の面に、導電性フィラーを含む四フッ化エチレン系樹脂から形成されている表面層を形成する表面層形成工程を含み、
製造される離型フィルムの表面抵抗率 R_s が $1 \times 10^{11} \Omega$ 以下である、
離型フィルムの製造方法。